PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-160046

(43)Dat of publication of application: 20.06.1997

(51)Int.CI.

G02F 1/1337 G02F 1/1337

G02F 1/133 C08G 69/26 C08G 73/10

(21)Application number: 07-318885

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

07.12.1995

(72)Inventor: YOKOKURA HISAO

NAKADA TADAO FUNAHATA KAZUYUKI ARAYA SUKEKAZU KONDO KATSUMI

(54) COMPOSITION FOR LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT LAYER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the occurrence of an afterimage unevenness and brightness unevenness while enlarging the pretilt angle of a liquid crystal cell by using a polymer of a specified diamine compd. and tetracarboxylic acid and its deriv. as an org. oriented film.

SOLUTION: This composition contains the polymer of an ortho type diamine consisting of a binding group hardly containing a polar group between an aromatic ring and the aromatic ring, the tetracarboxylic acid and its deriv. The ortho type diamine is an aromatic diamine containing a linear binding group preferably. Then the org. oriented film is obtained by dehydrocyclization after applying each precursor, for example poly (amic acid) and poly (amic acid)— imide, etc., on the substrate. In the liquid crystal alignment layer using such a composition, high pretilt angle, charging residual DC and discharge time, the

frequency dependence of threshold voltage and the

	THING (dev)	金融の使用で(mV)	関連場所の 国政務的な	(%) (%)
東陸で 対象 1	3,5	30mV	0.9920	98
7.20 1502	4.8	80 84	0.8958	,9.B
200 150 N	5.1.	8 0 m V 640	O BRIT	89
空域の 野猫 4	4.3	100mV	G. H B. FU	280
美数0 沙雅5	5 € 3	2 UmV 49	0.8944	Ð 4
支証の 分数日	\$ 9.3 9	30mV 34	0.8870	9.6
北海の 月間7	3.3	80mV 39	0.0024	0.4
此數例:	4200	200my 280	0.9720	90
北约 图 2	4.3	150mV 805	0.9850	95

characteristic of voltage retention are improved compatibly. In this way, a liquid crystal display device especially low in generation of the brightness unevenness and the afterimage unevenness of a picture residual and high in display quality is obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application oth r than the examiner's decision of rejection or application conv rt d r gistration]

[Dat of final disposal for application]

'[Patent numb r] [Dat of r gistration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against xaminer's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-160046

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

51) Int. Cl. d	識別配号	庁内整理番号	F I		技術表示簡所
G02F 1/1337	520		G02F 1/13	520	及附及小面加
	5 2 5			525	
CO8G 69/26	NSG		C08G 69/26		
73/10	NTF		73/10		
			審査請求	未請求 請求項の数10	OL (全9頁)
1)出顯番号	特顧平7-318	8 8 5	(71)出願人	0 0 0 0 0 5 1 0 8	
				株式会社日立製作所	
2)出顧日	平成7年(199	5) 12月7日		東京都千代田区神田駿河	「台四丁目6番地
			(71)出顧人	0 0 0 0 0 4 4 5 5	
				日立化成工業株式会社	
				東京都新宿区西新宿2丁	目1番1号
			(72)発明者	横倉 久男	•
				茨城県日立市大みか町七	丁目1番1号 株
			1	式会社日立製作所日立研	究所内
•			(72)発明者	中田 忠夫	
				茨城県日立市大みか町七	丁目1番1号 株
				式会社日立製作所日立研	究所内
			(74)代理人	弁理士 高崎 芳紘	
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】液晶配向膜用組成物

(57)【要約】

【課題】 表示むらを低減することができる液晶配向膜 用組成物を提供すること。

【解決手段】 被晶表示素子用の液晶配向膜用組成物として芳香環と芳香環の間に極性基を含まない結合基から成るオルト型のジアミンとテトラカルポン酸またはその誘導体の重合物を使用する。

【効果】 充電残留 D C と放電時間、閾値電圧の周波数 依存性および電圧保持率の特性が両立して向上し、表示 むらの発生が少ない高表示品質の液晶表示素子が達成され、最終的には製品の歩留まりを大きく向上することが できる。

	プレ5かト角 (deg)	充電残留DC(mV) 放電時間(分)	関値電圧の 周波数特性	電圧保持率 (%)
実施の 形態 1	4.5	50mV 33	0.9920	92
実施の 形態2	4.2	80mV 35	0.9958	96
実施の 形態3	5.1	80mV 59	0.9942	93
実施の 形態 4	4.8	100mV 5分	0.9890	88
実施の 形態5	5.0	70mV 457	0.8944	8 4
実施の 形態8	4.8	50mV 33	0.9910	80
実施の 形態7	4.4	80mV 849	0.9924	84
比較例 1	4.0	200mV 259	0.9720	80
比較例2	4.5	150mV 30#	0.8650	65

【特許請求の範囲】

【節求項1】 芳香環と芳香環の間に極性基を含まない 結合基から成るオルト型のジアミンとテトラカルポン酸 およびその誘導体の重合物を含有することを特徴とする 液晶配向膜用組成物。

【請求項2】 上記オルト型のジアミンが直鎖状の結合 基を含有する芳香族ジアミンであることを特徴とする、 請求項1記載の液晶配向膜用組成物。

アルキル側鎖を含有することを特徴とする、前求項1記 10 載の液晶配向膜用組成物。

【醋求項4】 上記オルト型のジアミンがハロゲン基を 含まない他のジアミンを含有することを特徴とする、請 求項1記載の液晶配向膜用組成物。

【請求項5】 上記オルト型のジアミンがハロゲン基を 含まない他の長鎖炭化水素ジアミンを含有することを特 徴とする、請求項1記載の液晶配向膜用組成物。

【請求項6】 上記オルト型のジアミンを少なくとも5 モル%以上含有することを特徴とする、 請求項1記載の 液晶配向膜用組成物。

【請求項7】 上記オルト型のジアミンが一般式 【化1】

(式中、Yは-NH2を示し、Xは- (CH2) n- (n =1~8)、Zは水素もしくはアルキル基を示す。)で 表わされる化合物を含有することを特徴とする、請求項 1 記載の液晶配向膜用組成物。

【請求項8】 上記オルト型のジアミンの重合物が非架 橋型であることを特徴とする、箭求項1記載の液晶配向 膜用組成物。

【簡求項9】 上記オルト型のジアミンの重合物がポリ アミック酸であることを特徴とする、請求項1配載の液 晶配向膜用組成物。

【請求項10】 上記オルト型のジアミンの重合物がポ リアミック酸-イミド、ポリアミック酸-シロキサン、 ポリイミド、ポリイミドーシロキサン、ポリアミドーイ ミド、ポリアミドの中から選ばれた少なくとも一つであ 40 ることを特徴とする、欝求項1配載の液晶配向膜用組成 Otto _

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、オルト型のジアミ ン化合物とテトラカルポン酸およびその誘導体より成る 重合物の液晶配向膜用組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】ネマチック液晶を、互いに対向する一方

る2枚の基板の間にサンドイッチ状に挟さみ、液晶分子 の長軸を基板間で180度以上捩じるスーパーツイスト 液晶表示素子、アクティブ・マトリックス型電極基板上 で被晶を駆動するアクティブ・マトリックス液晶表示素 子、等が開発されている。スーパーツイスト液晶表示素 子およびアクティブ・マトリックス液晶表示素子をポリ イミドの有機配向膜を用いて作製すると、プレチルト角 が小さいために発生するスキャツタリング(光散乱)ド メインおよびエッジ・ドメイン等の問題があった。そこ で、プレチルト角が大きい種々のポリイミド配向膜が提 案されている(特開昭64-25127号公報、特開昭 6 2 - 2 6 2 8 2 9 号公報、特開昭 6 3 - 2 6 2 6 2 0 号公報、特開平2-210328、特開平2-2500 33号公報、特開平4-294327号公報、特開平4 - 2 8 1 4 2 7 号公報、特開平4 - 2 9 1 2 3 4 号公 報、特開平5-43687号公報)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、スーパ ~ツイスト液晶表示素子およびアクティブ・マトリック 20 ス液晶表示素子においては、表示品質向上や低コスト化 等が要求されているため、表示むらの発生しない液晶素 子を歩留まり良く作製することが必要になっている。図 1はスーパーツイスト液晶表示素子の模式的断面図を示 す。ガラス基板7の一方の面上にアルカリ防止膜8を設 け、その上に透明電極1を所定のパターンに形成し、上 記透明電極1を覆うように配向膜9を設け、他方の面上 に位相差板6および偏光板5を形成する。他の1枚のガ ラス基板7の一方の面上に設けられたアルカリ防止膜8 上には、上記透明電極1に対向する位置にカラーフィル 30 タ11を形成し、その上に保護膜10、透明電極1、配 向膜9を相ついで設け、他方の面上に位相差板6および 偏光板5を形成する。上記2枚のガラス基板7はそれら の上に設けられた透明電極1が互いに対向するように配 置され、液晶2がスペーサ4とともにそれらの間に注入 され、シール剤3で封止される。他方、図2はアクティ ブ・マトリックス液晶表示素子の模式的断面図を示す。 ガラス基板7の一方の面上に透明電極1およびアクティ ブ・マトリックス素子12を所定のパターンに形成し、 上記透明電極1を覆うように配向膜9を設け、他方の面 上に偏光板5を形成する。他の1枚のガラス基板7の一 方の面上には、上記透明電極1に対向する位置にカラー フィルタ11を形成し、その上に保護膜10、透明電極 1、配向膜9を相ついで設け、他方の面上に偏光板5を 形成する。上配2枚のガラス基板7は、前配と同様に、 それらの上に設けられた透明電極1が互いに対向するよ うに配置され、液晶2がスペーサ4とともにそれらの間 に注入され、シール剤3で封止される。

【0004】従来のポリイミド配向膜では、液晶セルの プレチルト角が大きくなり、スキャツタリング・ドメイ の面上にポリイミドからなる有機配向膜が設けられてい 50 ンやエッジ・ドメインの発生は低波されるが、画像残り

3

の残像むらや輝度むらが発生する問題がある。そのた め、これまでの配向膜を改良して表示むらを低減し、歩 留まりを向上させる大きな課題がある。本発明の目的 は、液晶セルのプレチルト角を大きくしながら、かつ残 . 像むらおよび輝度むらが発生しにくい液晶配向膜用組成 物を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上配目的を達成するため に、本発明者らは鋭意検討した結果、従来のパラ型、メ 夕型のジアミン化合物を用いた重合物の有機配向膜とは 異なり、芳香環と芳香環の間に極性基を含まない結合基 から成るオルト型のジアミン化合物とテトラカルポン酸 およびその誘導体の重合物の有機配向膜とすることによ り、上記課題が解決できることを見出し、本発明に至っ た。

【0006】本発明者らは、大きな課題となっている残 像むらや輝度むらの表示むらの主な要因が未だ明らにな っていないため、種々のジアミン化合物を用いて重合物 を合成し、化学構造と表示むらおよび液晶セル特性の関 係を検討した。その結果、残像むらや輝度むらの表示む らは液晶セル特性の充電残留DCと放電時間、閾値電圧 の周波数特性および電圧保持率に関与し、液晶セルの上 記特性が向上すれば改良されるという知見を得た。特 に、芳香環と芳香環の間に極性基を含まない結合基から 成るオルト型のジアミン化合物を用いた重合物の有機配 向膜を用いれば、充電残留DCと放電時間、閾値電圧の 周波数特性および電圧保持率が向上し、残像むらや輝度 むらの表示むらが発生しにくい液晶表示素子が得られる ことが分かった。

【0001】この理由ははっきりしないが、従来のパラ 型構造で表わされる重合物に較べ、オルト型のコンフォ メーションを有する重合物の方が帯電性が低く、イオン 性不純物の配向膜への吸着度合いも拘束され、輝度むら に関与する閾値電圧の周波数特性の電圧変動と透過率変 動も小さくて、電圧保持率も高いため、電界印加駆動時 に表示むらが発生しにくくなったものと推定される。さ らに、プレチルト角に関しても、オルト型のコンフォメ ーションにより歪みがより大きくなって、液晶分子の大 きなプレチルト角が得られたものと推定される。

[0008]

【発明の実施の形態】本発明の有機配向膜は、各々の前 駆体例えばポリアミック酸、ポリアミック酸ーイミド、 ポリアミック酸ーシロキサン、ポリイミド、ポリイミド - シロキサン、ポリアミド-イミドを基板上に盤布後、 脱水閉環して得られる。また、オルト型のジアミン化合 物にハロゲン基を含まないジアミン化合物を共重合もし くは重合物同志を混合しても有機配向膜として使用可能 である.

【0009】本発明に用いられる芳香環と芳香環の間に

合物としては、一般式としては次式がある。 【化2】

$$z \sim x \sim z$$

本発明に用いられる芳香環と芳香環の間に極性基を含ま ない結合基から成るオルト型のジアミン化合物として は、例えば、 2 , 2 ' - ジアミノジフェニルメタン、 2 , 2'-ジアミノジフェニルエタン、2,2'-ジアミノジ フェニルプロパン、2,2'-ジアミノジフェニルプタ ン、 2,2'ージアミノジフェニルペンタン、 2,2'ージ アミノジフェニルヘキサン、 2 , 2 ' - ジアミノジフェニ ルヘプタン、2,2'ージアミノジフェニルオクタン、 3,3'-ジメチル-2,2'-ジアミノジフェニルメタ ン、3,3'-ジメチル-2,2'-ジアミノジフェニルエ タン、3,3'ージメチルー2,2'ージアミノジフェニル プロパン、 3,3'ージメチルー 2,2'ージアミノジフェ ニルプタン、3,3'-ジメチル-2,2'-ジアミノジフ エニルペンタン、3,3'-ジメチル-2,2'-ジアミノ ジフェニルヘキサン、3,3'-ジメチル-2,2'-ジア ミノジフェニルヘプタン、3,3'-ジメチル-2,2'~ ジアミノジフェニルオクタン、3,3'-ジプチル-2, 2'-ジアミノジフェニルメタン、3,3'-ジプチルー 2,2'-ジアミノジフェニルエタン、3,3'-ジプチル - 2,2'-ジアミノジフェニルプロパン、3,3'-ジブ チルー2,2'-ジアミノジフェニルブタン、3,3'-ジ プチルー2,2'ージアミノジフェニルペンタン、3,3' - ジプチル - 2 , 2 ' - ジアミノジフェニルヘキサン、 3,3'-ジプチルー2,2'-ジアミノジフェニルヘプタ ン、 3,3'ージプチルー 2,2'ージアミノジフェニルオ クタン、3,3',5,5'ーテトラメチルー2,2'ージア ミノジフェニルメタン、3,3',5,5'-テトラメチル - 2,2'-ジアミノジフェニルエタン、3,3',5,5' ーテトラメチルー2,2'ージアミノジフェニルブタン、 等が挙げられ、これらを単独でまたは組み合わせて使用 することができる。

【0010】また、上記ジアミン化合物と共重合される ことができる、ハロゲン基を含まないジアミンとして 40 は、例えば、p-フェニレンジアミン、m-フェニレン ジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル-3-カルポンアミ ド、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、3,3'-ジア ミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルプ ロパン、3,3'ージアミノジフェニルプロパン、4,4' ージアミノジフェニルスルホン、 3 , 3 ' ージアミノジフ エニルスルホン、1,5-ジアミノナフタレン、2,6-ジアミノナフタレン、4.4'-ジアミノターフェニル、 1,1-メタキシリレンジアミン、1,4-ジアミノシク 極性基を含まない結合基から成るオルト型のジアミン化 50 ロヘキサン、2-ドデシルオキシ-1,4-ジアミノベ

ンゼン、3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノジフェニ ルメタン、3,3'ージブチルー4,4'ージアミノジフェ ニルメタン、3,3'-ジプトキシ-4,4'-ジアミノジ フェニルメタン、2,4-ジアミノ-1-ドデシルベン ゼン、2,4-ジアミノ-1-オクチルペンゼン、2,4 - ジアミノ-1-オクチルオキシベンゼン、 2 , 4 -ジ アミノラウリルフェニルエーテル、 2,4 - ジアミノス テアリルフェニルエーテル、3,3'-ジメチル-4,4' -ジアミノジフェニルエーテル、1,6-ジアミノヘキ サン、1,8-ジアミノオクタン、1,10-ジアミノデ 10 カン、1,12-ジアミノドデカン、イソフタル酸ジヒ ドラジド、2,2-ピス〔4-(4-アミノフェノキ シ) フェニル) プロパン、2,2-ピス [4-(4-ア ミノフェノキシ) フェニル] オクタン、2,2-ピス 〔4-(4-アミノフェノキシ) フェニル〕 ペンタデカ ン、2,2-ピス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェ ニル〕メタン、 2,2 - ピス〔4 - (4 - アミノフェノ キシ)フェニル〕スルホン、2,2-ピス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ケトン、 2,2 ~ビス 〔4- (4-アミノフェノキシ)フェニル〕ピフェニ ル、2,2-ピス〔4- (4-アミノフェノキシ) フェ ニル〕シクロヘキサン、2,2-ピス〔4-(4-アミ ノフェノキシ)フェニル〕メチルシクロヘキサン、ピス 〔4-(4-アミノペンソイルオキシ) 安息香酸〕プロ パン、ピス〔4-(4-アミノベンゾイルオキシ)安息 香酸〕オクタン、ピス〔4-(4-アミノベンゾイルオ キシ) 安息香酸] シクロヘキサン、ピス〔4-(4-ア ミノペンソイルオキシ) 安息香酸] メチルシクロヘキサ ン、ピス〔4-(4-アミノメチルペンゾイルオキシ) 安息香酸〕プロパン、ピス(4-アミノペンゾイルオキ シ) プロパン、ピス(4-アミノベンゾイルオキシ) メ タン、ピス (4-アミノペンゾイルオキシ) オクタン、 ピス (4-アミノベンゾイルオキシ) オクタデカン、ビ ス〔2-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕メタン、 ピス〔2-(4-アミノフェノキシ)-5-メチルフェ ニル〕メタン、ピス〔2-(4-アミノフェノキシ)-3, 5 - ジメチルフェニル] メタン、ピス、[2 - (4 -アミノフェノキシ) - 3,4,5 - トリメチルフェニル〕 メタン、ピス〔2-(4-アミノフェノキシ)-3,5, 6 - トリメチルフェニル)メタン、ピス〔2 - (4 - ア ミノフェノキシ) -5-エチルフェニル] メタン、ピス 〔2- (4-アミノフェノキシ) - 3.5 - ジエチルフ ェニル] メタン、ピス〔2-(4-アミノフェノキシ) - 5 - n - プロピルフェニル)メタン、ピス〔2 - (4 - アミノフェノキシ) - 5 - イソプロピルフェニル)メ タン、ピス〔2- (4-アミノフェノキシ)-3-メチ ルー5 - イソプロピルフェニル〕メタン、ピス〔2 -(4-アミノフェノキシ) -5-メチル-3-イソプロ ピルフェニル] メタン、ピス〔2- (4-アミノフェノ キシ)-5-n-ブチルフェニル〕メタン、ピス〔2-

(4-アミノフェノキシ) -5-イソプチルフェニル) メタン、ピス〔2-(4-アミノフェノキシ)-3-メ チルー5-t-プチルフェニル} メタン、ピス [2-(4-アミノフェノキシ) - 5-メチル-3-t-ブチ ルフェニル〕メタン、ビス〔2- (4-アミノフェノキ シ) - 3 - メチル - 5 - オクチルフェニル〕メタン、ビ ス〔2- (4-アミノフェノキシ) -3-メチル-5-ノニルフェニル〕メタン、ピス〔2- (4-アミノフェ ノキシ) - 5 - シクロヘキシルフェニル) メタン、ピス 〔2-(4-アミノフェノキシ)-3-メチル-5-シ クロヘキシルフェニル〕メタン、ビス (2-(4-アミ ノフェノキシ)-5-メチル-3-シクロヘキシルフェ ニル] メタン、ビス〔2-(4-アミノフェノキシ) -5-フェニルフェニル] メタン、ピス [2-(4-アミ ノフェノキシ) - 3 - メチル - 5 - フェニルフェニル) メタン、1,1-ピス〔2- (4-アミノフェノキシ) - 5 - メチルフェニル] エタン、1,1 - ピス 〔2 -(4-アミノフェノキシ) -3、5-ジメチルフェニ ル) エタン、1,1-ピス〔2- (4-アミノフェノキ 20 シ) - 5 - メチルフェニル] プロパン、2、2 - ピス 〔2-(4-アミノフェノキシ) フェニル〕オクタン、 1,1-ピス〔2-(4-アミノフェノキシ)-3,5-ジメチルフェニル〕プロパン、 2,2 - ピス〔2 - (4 -アミノフェノキシ)フェニル]デカン、2.2-ピス 〔2-(4-アミノフェノキシ) フェニル) プロパン、 2,2-ピス〔2-(4-アミノフェノキシ)フェニ ル) ドデカン、2,2-ピス〔2-(4-アミノフェノ キシ) -3,5-ジメチルフェニル] プロパン、1,1-ピス〔2-(4-アミノフェノキシ)-5-メチルフェ 30 ニル] プタン、2,2-ビス [2-(4-アミノフェノ キシ) -3,5-ジメチルフェニル〕プタン、1,1-ビ ス〔2-(4-アミノフェノキシ)-5-メチルフェニ ル] - 3 - メチルプロパン、1,1 - ピス〔2 - (4 -アミノフェノキシ) - 5 - メチルフェニル] シクロペン タン、1, 1-ピス〔2-(4-アミノフェノキシ)-3,5-ジメチルフェニル] シクロ ヘキサン、1,1-ピス〔2-(4-アミノフェノキシ)-5-メチルフェ ニル 】 - 3,3,5 - トリメチルシクロヘキサン等のジ アミン、さらに

[化3]

40

[化4]

のジアミノシロキサン等が挙げられるが、これらに限定されるものではなく、また、これらは単独でまたは組み合わせて使用することができる。

【0011】一方、テトラカルポン酸成分としては、例 えばピロメリット酸二無水物、メチルピロメリット酸二 無水物、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルポン酸 二無水物、3,3',4,4'-ペンゾフェノンテトラカル ボン酸二無水物、3,3',4,4'-ジフェニルメタンテ トラカルポン酸二無水物、3,3',4,4'-ジフェニル エーテルテトラカルポン酸二無水物、3,3',4,4'-ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、 2,3, 6,7-ナフタレンテトラカルポン酸二無水物、3,3', 4,4'ージフェニルプロパンテトラカルポン酸二無水 物、2,2-〔4-(3,4-ジカルポキシフェノキシ) フェニル〕プロパンテトラカルポン酸二無水物、 2,2 - 〔4 - (3,4 - ジカルポキシフェノキシ)フェニ ル〕オクチルテトラカルポン酸二無水物、2,2-〔4 ~ (3,4-ジカルボキシベンゾイルオキシ)フェニ ル〕プロパンテトラカルポン酸二無水物、 2,2 - ピス [4-(3,4-ジカルポキシフェノキシ)フェニル] トリデカンテトラカルポン酸二無水物、シクロペンタン テトラカルポン酸二無水物、シクロプタンテトラカルポ ン酸二無水物、ブタンテトラカルポン酸二無水物、 シク ロヘキサンテトラカルポン酸二無水物、1,4-シクロ ヘキサンジカルボン酸クロライド、 4,4'ージフェニル メタンジカルボン酸クロライド、イソフタル酸、イソフ タル酸クロライド、アジピン酸、アジピン酸クロライ ド、ステアリン酸クロライド、等が挙げられ、これらを 単独でまたは組み合わせて使用することができる。

【0012】さらに、液晶配向膜用組成物はN-メチル-2-ピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキサイド、スルフォラン、ブチルラクトン、クレゾール、フェノール、シクロヘキサノン、ジオキサン、テトラヒドロフラン、ブチルセルソルブ、ブチルセルソルブアセテート、アセトフェノン、等の溶媒中で、-20~200℃で関合することができる。

【0013】また、液晶配向膜用組成物は、ァーアミノ シール剤を印刷後、ZLI-4792(メルク社製商品 プロピルトリエトキシシラン、8-アミノプロピルメチ 50 名)液晶を封入して液晶セルを作製し、エージング処理

ルジエトキシシラン、N-B (アミノエチル) ァーアミノプロピルトリメトキシシラン、等のアミノ系シランカップリング剤、エポキシ系シランカップリング剤、チートカップリング剤、アルミニウムアルコレート、ジルコニウムキレート、デルコニウムキレート、デルコニウムキレート、デルコニウムキレート、開配中で混合するもしくは反応させることもできる。上配向膜の形成は、一般的なスピンコート、印刷、刷毛盤り、スプレー法、等によって行なうことができる。

【0014】用いる液晶材料としては、例えば4一置換 10 フェニルー 4'ー 置換シクロヘキサン、4ー置換シクロ ヘキシルー 4'- 置換シクロヘキサン、4- 置換フェニ ルー 4 ' - 置換ジシクロヘキサン、 4 - 置換ジシクロヘ キシル - 4' - 置換ジフェニル、4 - 置換 - 4" - 置換タ - フェニル、4 - 置換ピフェニル - 4 ' - 置換シクロへ キサン、2- (4- 置換フェニル)-5- 置換ピリミジ ン、4-置換安息香酸-4'-フェニルエステル、4-置換シクロヘキサンカルポン酸~ 4 ′~ 置換フェニルエ ステル、4 - 置換シクロヘキサンカルポン酸 - 4 ' - 置 換ピフェニルエステル、4-(4-置換シクロヘキサン 20 カルポニルオキシ) 安息香酸 - 4'- 置換フェニルエス テル、 4 - (4 - 置換シクロヘキシル) 安息香酸 - 4' - 置換フェニルエステル、 4 - (4 - 置換シクロヘキシ ル)安息香酸 - 4'- 蹬換シクロヘキシルエステル、 4 - 囮換 - 4 ′ - 置換ピフェニル、等を挙げることがで き、これらの化合物の中でも、少なくとも分子の一方の 末端にアルキル基、アルコキシ基、アルコキシメチレン 基、シアノ基、フッ素基、ジフッ素基、トリフッ素基を 有する多成分系の混合液晶組成物が用いられる。

【0015】上配組成物を用いた配向膜を持った液晶表 30 示素子を形成し、種々の液晶セル特性を測定し、比較例 と比較した。以下、本発明を実施の形態によって具体的 に説明する。

[0016]

【実施の形態1】3,3',5,5'-テトラメチル-2; 2'-ジアミノジフェニルメタン0.1モル%をN-メチ ルー2-ピロリドンに溶解後、ピロメリット酸二無水物 0.05モル%およびシクロペンタンテトラカルポン酸 二無水物 0.05 モル%を加え、5℃で7時間反応さ せ、淡黄色の粘稠なワニスを得た。そのワニスをジメチ 40 ルアセトアミドとブチルセルソルブの溶剤を用いて5重 **鼠%濃度に希釈後、ァーアミノプロピルトリエトキシシ** ランを固形分で4重量%添加して液晶配向膜用組成物の 脚合を行なった。その後、ITO (indium-tin-oxide) 透明電極付きガラス基板上にスピンナー釜布後、150 ℃で仮焼成、220℃で1時間加熱硬化を行ない、約6 0 n m のポリイミド膜を形成した。さらに、 0 . 3 m m の切込み、 7 0 0 r p m の回転数、 1 0 0 0 m m / m i пの送り速度の条件でラピングを行ない、エポキシ系の シール剤を印刷後、ZLI-4792(メルク社製商品

後、クリスタルローテーション法でプレチルト角を測定 したところ4.5° であった。

【0017】さらに、上配の条件で作製した液晶ユニッ ト素子14を偏光板5で挟み、恒温槽13の中に設置 し、図3に示す装置を用いて振幅6V、オフセット1V で、周波数30Hzの矩形波を30分印加時の充電残留 DCおよびフリッカの放電時間を評価した。 図中、15 はパックライトであり、16はパルス・ジェネレータ、 17は直流電源、18はフォトダイオード、19はオッ シロスコープを示す。充電残留DCは50mV、フリッ カの放電時間は3minであった。閾値電圧の周波数特 性は、図4に示すように、1kHzにおける閾値電圧に 対する30Hzにおける閾値電圧の比で評価し、0.9 920であった。電圧保持率は、図5に示す装置を用い てソース信号が振幅 6 V、オフセット 0 Vで 1 6 5 m s の矩形波、ゲート信号のパルス幅35μsの条件で、ソ - ス 信 号 の 実 効 値 に 対 す る ド レ イ ン か ら の 出 力 信 号 の 実 郊値の比で評価し、92%であった。以上の結果を図6 に纏めた。図5中、20はパッファアンプを示す。

【0018】つぎに、上配配向膜ワニスをカラーフィル ター付きの透明電極基板上に印刷塗布後、上記と同様に して約60nmのポリイミド膜を形成した。さらに、上 記基板に挟持する液晶分子のツイスト角を250度にす るために上下の基板をそれぞれの角度でラビングして、 上記基板間にシール印刷後、4-置換フェニルー4'-個換シクロヘキサン、4 - 個換シクロヘキサンカルポン 酸 - 4 ' - 囮換 フェニルエステル、 4 - 囮換 シクロヘキ シルー4'~置換シクロヘキサン、4-置換フェニル-4′- 置換ジシクロヘキサン、4- 置換ジシクロヘキシ . ルー 4 '一 質換ジフェニルの一方の末端にアルキル基、 シアノ基、フッ素基またはジフッ素基を有する液晶成分 に、さらにカイラル剤S811 (メルク社製商品名) を 0.5 重量%添加した液晶組成物を封入してスーパーツ イスト液晶表示素子を作製した。その後、エージング処 理して、画面上にウィンドのパターンを表示した結果、 輝度むらおよび残像むらが低減された液晶表示素子を得 た。

[0019]

【実施の形態2】2,2'-ジアミノジフェニルエタン 0.08モル%および

【化2】に示すジアミノシロキサン0.02モル%をN ーメチルー2-ピロリドンに溶解後、ピロメリット酸ニ 無水物 0 . 0 5 モル % およびシクロブタンテトラカルポ ン酸二無水物 0.05モル%を加え、10℃で8時間反 応させ、淡黄色の粘稠なワニスを得た。そのワニスを用 いて実施の形態 1 と同様にして液晶配向膜用組成物の調 合を行なった後、ITO透明電極付きガラス基板上にス ピンナー強布後、150℃で仮焼成、200℃で1時間 加熱硬化を行ない、約50nmのポリイミドシロキサン 膜を形成した。ついで、実施の形態1と同じ条件でプレ 50 チルト角を測定し、さらに上配の条件で作製した液晶セ ルの充電残留DCと放電時間、閾値電圧の周波数特性お よび電圧保持率も測定した。それらの結果を図6に示 す。

【0020】つぎに、上配の配向膜ワニスをカラーフィ ルター付きのアクティブ・マトリックス用の基板上に上 記と同様にして約50mmのポリイミドシロキサン膜を 形成した。さらに、上記基板に挟持する液晶分子のツィ スト角を90度にするために上下の基板をそれぞれの角 10 度でラピングして、上記基板間にシール印刷を行なって ギャップ 6.5 μmの素子にフッ素系、ジフッ素系また はトリフッ素系の混合液晶組成物を封入してアクティブ ・マトリックス液晶表示素子を作製した。その後、エー ジング処理して、画面上にウィンドのパターンを表示し た結果、輝度むらおよび残像むらが低減された液晶表示 素子を得た。

[0021]

20

・【実施の形態3】2,2'ージアミノジフェニルプロパン 0.09モル%および2,4-ジアミノステアリルフェニ ルエーテル 0 . 0 1 モル % を N - メチル - 2 - ピロリド ンに溶解後、イソフタル酸クロライド 0.1 モル%を加 え、5℃で7時間反応させ、淡黄色の粘稠なワニスを得 た。反応ワニスをアルコールと純水の混合液に加え、沈 殿物を濾過、乾燥してジメチルアセトアミドとブチルセ ルソルブの溶剤を用いて5重量%濃度に希釈後、ィーア ミノプロピルトリエトキシシランを固形分で4重量%添 加して、液晶配向膜用組成物の調合を行なった。その 後、ITO透明電極付きガラス基板上にスピンナー塗布 し、150℃で仮焼成、180℃で1時間加熱硬化を行 30 ない、約65 n m のポリアミド膜を形成した。さらに、 実施の形態1と同じ条件で液晶セルの諸特性を測定し、 それらの結果を図6に示す。

【0022】つぎに、上記の配向膜ワニスをカラーフィ ルター付きの透明電極基板上に印刷塗布後、150℃で 仮焼成、200℃で1時間加熱硬化を行ない、約65n mのポリアミド膜を形成した。さらに、上記基板に挟持 する液晶分子のツイスト角を220度にするために上下 の基板をそれぞれの角度でラピングして、上記基板間に シール印刷を行なってギャップ 6 μmの素子に実施の形 40 態1の混合液晶組成物を封入してスーパーツイスト液晶 表示素子を作製した。その後、エージング処理して画面 上にウィンドのパターンを表示した結果、輝度むらおよ び残像むらが低減された液晶表示素子を得た。

[0023]

【実施の形態4】 3,3',5,5'ーテトラメチルー2. 2'-ジアミノジフェニルメタン 0 . 0 8 モルおよびイソ フタル酸ジヒドラジド 0.02モル%をN-メチル-2 - ピロリドンに溶解後、ブタンテトラカルポン酸二無水 物 0 . 0 5 モル% およびシクロペンタンテトラカルポン 酸二無水物 0.05 モル%を加え、5℃で7時間反応さ

11 .

せ、淡黄色の粘稠なワニスを得た。そのワニスを用いて 実施の形態 1 と同様にして約 6 0 nmのポリアミドイミ ド膜を形成した。さらに、実施の形態1と同じ条件で液 晶セルの諸特性を測定し、それらの結果を図6に示す。 【0024】つぎに、上記の配向膜ワニスを用いてカラ - フィルタ-付きの透明電極基板上に実施の形態1と同 様にして約65nmのポリアミドイミド膜を形成した。 さらに、基板に挟持する液晶分子のツイスト角を90度 にするために上下の基板をそれぞれの角度でラビングし て、上記基板間にシール印刷を行なってギャップ 6.0 μ mの素子にフッ素系、ジフッ素系またはトリフッ素 系の混合液晶組成物を封入してアクティブ・マトリック ス液晶表示素子を作製した。その後、エージング処理し て画面上にウィンドのパターンを表示した結果、輝度む らおよび残像むらが低減された液晶表示素子を得た。 [0025]

【実施の形態 5】 2,2'ージアミノジフェニルエタン 0.05モル%および 4,4'ージアミノジフェニルメタン 0.04モル%および 2,4ージアミノラウリルフェニルエーテル 0.01モル%を Nーメチルー 2ーピロリドンに溶解後、ピロメリット酸酸ニ無水物 0.05モル%およびシクロヘキサンテトラカルボン酸ニ無水物 0.05モル%を加え、20℃で7時間反応させ、淡黄色の粘稠なワニスを得た。そのワニスを用いて実施の形態 2と同様にして約40nmのポリアミック酸ーイミド膜を形成した。さらに、実施の形態 1と同じ条件で液晶セルの賭特性を測定し、それらの結果を図6に示す。

【0026】つぎに、上配の配向膜ワニスを用いてカラ ーフィルター付きの透明電極基板上に実施の形態 2 と同 様にして約40nmのポリアミック酸ーイミド膜を形成 した。さらに、上記基板のラピング方向は互いにほゞ平 行で、かつ印加電界方向との角度を85度とした。基板 間のギャップは球形のポリマビーズを基板間に分散して 挟持し、4.5μmとした。なお、上記基板の一方には 信号電極と走査電極を形成 し、基板に平行に電界が印 加できるよう構成した。両基板上の電極には、いずれも 従来のアクティブ・マトリクス型液晶表示素子と同様の 手法で形成した幅 1 6 μmのクロム電極を用いたが、ア ルミニウム、銅、等の電気抵抗の低い金属であれば特に 制限はない。構成した液晶セルに、フッ素系、ジフッ素 系またはトリフッ素系の混合液晶組成物を封入して平行 電界型のアクティブ・マトリックス 液晶表示素子を作製 し、エージング処理後、画面上にウィンドのパターンを 表示しても輝度むらおよび残像むらが低減された液晶表 示案子を得た。

[0027]

【実施の形態 6】 3、3 ' ージメチルー 2、2 ' ージアミノジフェニルメタン 0・0 8 モル % および 4、4 ' ージアミノジフェニルメタン 0・0 2 モル % を N ーメチルー 2 ーピロリドンに溶解後、ピロメリット酸二無水物 0・0 5

モル ※ およびシクロブタンテトラカルボン酸二無水物 0.05 モル ※ を加え、0℃で3時間反応させ、淡黄色の粘稠なワニスを得た。反応ワニスを用いて実施の形態1と同様にして液晶配向膜用組成物の調合を行なった。その後、ITO透明電極付きガラス基板上にスピンナー 塗布後、150℃で仮焼成、230℃で1時間加熱 でを行ない、約45 n m のポリイミド膜を形成した。さらに、実施の形態1と同じ条件で液晶セルの賭特性を測定し、それらの結果を図6に示す。

10 【0028】 つぎに、上記の配向膜ワニスをカラーフィルター付きの透明電極基板上に印刷塗布後、150℃で仮焼成、230℃で1時間加熱硬化を行ない、約40nmのポリイミド膜を形成した。以下実施の形態5と同様にして輝度むらおよび残像むらが低減された液晶表示素子を得た。

[0029]

20

【実施の形態 7】 3、3、5、5、一テトラメチルー2、2、一ジアミノジフェニルエタン 0、0 8 モル % および 4、4、一ジアミノジフェニルメタン 0、0 2 モル % を N ーメチルー 2 ーピロリドンに溶解後、ブタンテトラカルボン酸ニ無水物 0、0 5 モル % を 加え、5 ℃で7 時間反応させ、淡黄色の粘稠なワニスを 押いて実施の形態 1 と同様にして約60 n mのポリアミック酸ーイミド膜を形成した。さらに、実施の形態 1 と同じ条件で液晶セルの賭特性を測定し、それらの結果を図 6 に示す。

【0030】つぎに、上配の配向膜ワニスを用いてカラーフィルター付きの透明電極基板上に実施の形態1と同様にして約60nmのポリイミド膜を形成した。さらに、上配基板に挟持する液晶分子のツイスト角を230度にするために上下の基板をそれぞれの角度でラピンンして、上配基板間にシール印刷を行なってギャップ6μmの素子に実施の形態1の液晶を封入してスーパーツイスト液晶表示素子を作製した。その後、エージング処理して適面上にウィンドのパターンを表示した結果、輝度むらおよび残像むらが低減された液晶表示素子を得た。【0031】

【比較例1】 p ーフェニレンジアミン 0 . 0 5 モル % および ピス〔4 ー (4 ー アミノフェノキシ) フェニル〕 プロパン 0 . 0 5 モル % を N ー メチルー 2 ーピロリドンに 溶解後、ピロメリット酸二無水物 0 . 0 5 モル % およびシクロプタンテトラカルポン酸二無水物 0 . 0 5 モル % を加え、5℃で7時間反応させ、淡黄色の粘稠なワニスを 得た。そのワニスを 用いて 実施の 形態 1 と同様にして 約 6 0 n m のポリアミック酸ーイミド膜を形成した。 さらに、実施の 形態 1 と同じ条件で液晶セルの 錯特性を 測定し、それらの結果を図 6 に示す。

【0032】 つぎに、上記の配向膜ワニスを用いてカラ 50 ーフィルター付きの透明電極基板上に実施の形態 1 と同

様にして約60nmのポリイミド膜を形成した。さらに、上配基板に挟持する液晶分子のツイスト角を240度にするために上下の基板をそれぞれの角度でラピングして、上配基板間にシール印刷を行なってギャップ6μmの素子に実施の形態1の液晶を封入してスーパーツイスト液晶表示素子を作製した。その後、エージング処理して画面上にウィンドのパターンを表示した結果、輝度むらおよび画像残りの残像むらが発生する液晶表示素子を得た。

[0033]

【比較例2】 4 . 4 ' - ジアミノジフェニルメタン 0 . 0 5 モル % および 2 . 2 - ピス 〔4 - (4 - アミノフェノキシ)フェニル〕 ヘキサフルオロプロパン 0 . 0 5 モル %を N - メチル - 2 - ピロリドンに溶解後、ピロメリット酸ニ無水物 0 . 0 5 モル % およびシクロペンタンテトラカルボン酸ニ無水物 0 . 0 5 モル %を加え、 0 ℃で 3時間反応させ、淡黄色の粘稠なワニスを得た。そのワニスを用いて実施の形態 2 と同様にして約 6 0 n m のポリアミック酸 - イミド膜を形成した。さらに、実施の形態 1 と同じ条件で液晶セルの諸特性を測定し、それらの結 20 果を図 6 に示す。

【0034】つぎに、上記の配向膜ワニスを用いて実施の形態2と同様にして約60nmのポリアミック酸ーイミド膜を形成した。さらに、上記基板に挟持する液晶分子のツイスト角を90度にするために上下の基板をそれぞれの角度でラピングして、上記基板間にシール印刷を行なってギャップ6.5μmの素子にフッ素系、ジフッ素系をはトリフッ素系の混合液晶組成物を封入してアクティブ・マトリックス液晶表示素子を作製した。その後、エージング処理して画面上にウィンドのパターン30を表示した結果、輝度むらおよび画像残りの残像むらが発生する液晶表示素子を得た。

[0035]

【発明の効果】本発明の液晶配向膜用組成物を用いた液晶配向膜では、高プレチルト角、充電残留 D C と放電時間、閾値電圧の周波数依存性および電圧保持率の特性が

両立して向上する。このことから、特に輝度むらおよび 画像残りの残像むらの発生が少ない高表示品質の被晶表 示素子が達成される。

【図面の簡単な説明】

【図1】スーパーツイスト液晶表示素子の部分断面図である。

【図2】アクティブ・マトリックス液晶表示素子の部分 断面図である。

【図3】残留直流電圧の測定系を示す図であるである。

10 【図4】閾値電圧の周波数特性を示すグラフである。

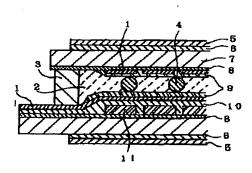
【図5】 電圧保持率の測定系を示す図および印加電圧波形図である。

【図 6 】 プレチルト角、残留直流電圧、周波数特性、電 圧保持率を示す図である。

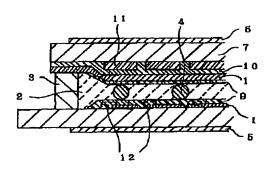
【符号の説明】

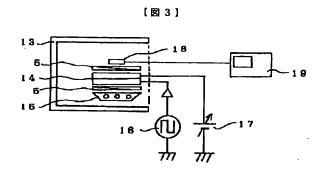
- 1 透明質極
- 2 液晶
- 3 シール剤
- 4 スペーサ
- 0 5 偏光板
 - 6 位相差板
 - 7 ガラス基板
 - 8 アルカリ防止膜
 - 9 配向膜
 - 10 保護膜
 - 11 カラーフィルタ
 - 12 アクティブ・マトリックス素子
 - 13 恒温槽
 - 14 ユニット素子
- 30 15 パックライト
 - 16 パルスジェネレータ
 - 17 直流電源
 - 18 フォトダイオード
 - 19 オシロスコープ
 - 20 パッファアンプ

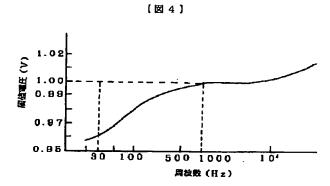
[図1]



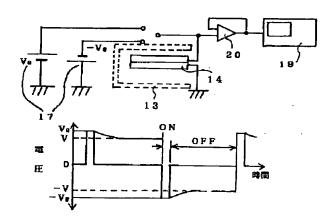
[図2]







【図5】



【図6】

	ブリが納角 (deg)	充電英留DC(mV) 放電時間(分)	関値電圧の 四波数特性	電圧保持率 (%)
実施の 形態 1	4.5	50mV 8 2	0.8820	9.5
実施の 形御2	4.2	80mV	0.9958	98
実施の 形態 8	5.1	80mV 55	0.9942	08
実施の 形態4	4.3	100mV	0.9890	88
実施の 形態 5	5.0	70mV	0.8944	94
実施の 形態 8	4.8	50mV 33	0.9910	90
実施の 形態7	4.4	80mV 39	0.8824	94
比較例 1	4.0	200my 25\$	0.8720	80
比較例2	4.5	150mV 302	0.8650	85

フロントページの続き

(72)発明者 舟幡 一行

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 荒谷 介和

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 近藤 克己

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-160048

(43) Date of publication of application: 20.06.1997

(51)Int.CI.

G02F 1/1337

(21)Application number: 07-321973

(71)Applicant: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO

(22)Date of filing:

11.12.1995

(72)Inventor: NISHIKAWA MICHINORI YASUDA YOSHITOMO

KAWAMURA SHIGEO MUTSUKA YASUAKI MATSUKI YASUO

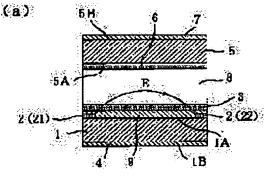
(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

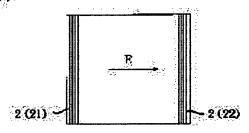
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display element of a transverse electric field control system which has the smaller dependency on visual field angles and with which the good display is assured within the wide visual field angles and after-images are hardly generated on a display screen after voltage

SOLUTION: A liquid crystal alignment layer 3 is formed on one surface 1A of an electrode substrate 1 provided with electrodes 2 for forming display pixels. A polarizing mans 4 is formed on the other surface 1B (b) of the electrode substrate 1. The liquid crystal oriented film 6 is formed on the one surface 5A of a counter substrate 5 arranged to face the electrode substrate 1. A polarizing means 7 is formed on the other surface 5b of the counter substrate 5. A liquid crystal layer 8 is held by the electrode substrate 1

and the counter substrate 5. The electrodes 2 are so constituted as to generate the electric fields nearly





parallel with the one surface 1A of the electrode substrate 1 by the voltage impressed from outside. The element is so constituted that the pretilt angle of the liquid crystal molecules by the liquid crystal alignment layer 3 formed on the one surface 1A of the electrode substrate 1 attains $\leq 1^{\circ}$.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application convert d r gistration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against xamin r's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of r j ction]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-160048

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

(51) Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02F 1/1337

525

G02F 1/1337

525

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全11頁)

(21)出願番号

特願平7-321973

(22)出顧日

平成7年(1995)12月11日

(71)出願人 000004178

日本合成ゴム株式会社

東京都中央区築地2丁目11番24号

(72)発明者 西川 通則

東京都中央区築地2丁目11番24号 日

本合成ゴム株式会社内

(72)発明者 保田 慶友

東京都中央区築地2丁目11番24号 日

本合成ゴム株式会社内

(72)発明者 河村 繁生

東京都中央区築地2丁目11番24号 日

本合成ゴム株式会社内

(74)代理人 弁理士 大井 正彦

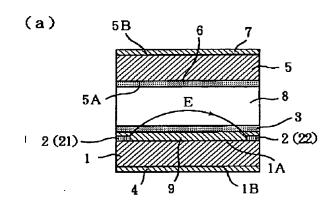
最終頁に続く

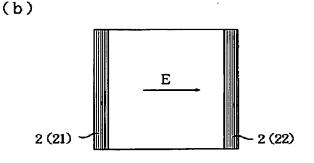
(54) 【発明の名称】液晶表示素子

(57)【要約】

【課題】 視野角依存性が小さくて広い視野角範囲において良好な表示を確保することができ、電圧解除後における表示画面に残像を生じさせにくい横電界制御方式の液晶表示素子を提供すること。

【解決手段】 表示画素を形成する電極2が設けられた電極基板1の一面1Aに被晶配向膜3が形成され、当該電極基板1の他面1Bには偏光手段4が形成され、前記電極基板1と対向配置されている対向基板5の一面5Aに被品配向膜6が形成され、前記電極基板1と前記式を1、前記電極2は、外には偏光手段7が形成され、前記電極基板1と前記式が外部から印加される電圧により、電極基板1の一面1Aに対しほぼ平行な電界を発生するよう構成され、前記電極基板1の一面1Aに対しほぼ平行な電界を発生するよう構成され、前記電極基板1の一面1Aに形成された液晶配向膜3による液晶分子のプレチルト角が1。以下であることを特徴とする。





20

50

【特許額求の範囲】

1

前記電極基板 (1) と対向配配されている対向基板 (5) の一面 (5A) に液晶配向膜 (6) が形成され、 当該対向基板 (5) の他面 (5B) には偏光手段 (7) が形成され、

前記電極基板 (1) と前記対向基板 (5) とにより液晶 図 (8) が挟持され、

前記電極 (2) は、外部から印加される電圧により、電極基板 (1) の一面 (1A) に対しほぼ平行な電界を発生するよう構成され、

前記電極基板 (1) の一面 (1A) に形成された液晶配向膜 (3) による液晶分子のプレチルト角が 1°以下であることを特徴とする液晶表示素子。

【請求項2】 電極基板(1)の一面(1 A)に形成された液晶配向膜(3)が、脂肪族および/または脂環式テトラカルポン酸二無水物とジアミン化合物とを反応させて得られるポリアミック酸、当該ポリアミック酸を脱水閉環して得られるイミド化重合体、脂肪族および/または脂環式テトラカルポン酸二無水物とジイソシアネート化合物とを反応させて得られるポリイミドから選ばれる少なくとも1種の重合体からなることを特徴とする請求項1記載の液晶表示案子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示素子に関する。さらに詳しくは、液晶分子に印加される電界の方向 30 が電極基板の一面に対しほぼ平行となる液晶表示素子であって、視野角依存性が小さく、残像が生じにくくてコントラストの高い優れた表示性能を有する液晶表示素子に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、被晶表示素子としては、透明電極が設けられている基板(電極基板)の一面にポリイミドなどからなる被晶配向膜を形成して被晶表示素子用基板とし、その2枚を対向配置して、その間隙内に正の誘電異方性を有するネマチック型液晶よりなる液晶層を形成してサンドイッチ構造のセルとし、電極基板の基板面に対してほぼ垂直方向の電界を液晶分子に印加させて駆動する方式による液晶表示素子が知られている。

【0003】また、最近において、被晶分子に印加する 電界を発生させるための電極を一方の基板のみに設け、 この基板(電極基板)の一面と、他方の基板(対向基 板)の一面とに液晶配向膜を形成し、両者の基板を対向 配置して、電極基板と対向基板との間隙内に液晶層を形 成してサンドイッチ構造のセルとし、電極基板の一面に 対してほぼ平行方向の電界を液晶分子に印加させて駆動 する方式(以下「横低界制御方式」ともいう。)を採用 した液晶表示素子が紹介されている(例えば「Asia Display '95」577頁参照)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】 横電界制御方式による 被晶表示素子は、従来の液晶表示素子に比べて視野角依 存性が小さいという利点を有している。しかしながら、 この方式において良好な視野角特性を得るための種々の 条件については現在のところ知見が少なく、良好な表示 状態を確保することのできる視野角範囲は、未だ狭いも のである。

【0005】また、液晶表示素子における画像表示時(電圧印加時)に発生し、液晶配向膜に吸着されて保持されたイオン性電荷が、画像消去後(電圧解除後における液晶配向膜から脱着されず、電圧解除後における液晶配向膜に大きな電圧が残留し、この残留電圧がそのまま液晶層に印加されて、電圧解除後における表示画面に残像を生じさせる、という問題がある。表示画面に残像が生じる場合には、電圧の印加時と解除時における明暗の差が小さくなり、良好なコントラストが得られない。

【0006】本発明の第1の目的は、視野角依存性が小さく、広い視野角範囲において良好な表示状態を確保することができる横電界制御方式の液晶表示素子を提供することにある。本発明の第2の目的は、電圧解除後において、液晶配向膜に蓄積されたイオン性電荷を迅速に脱着させることができ、電圧解除後における表示画面に残像を生じさせにくく、コントラストの高い横電界制御方式の液晶表示素子を提供することにある。

0 [0007]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示案子は、表示画案を形成する電極(2)が設けられた電極を板(1)の一面(1A)に液晶配向膜(3)が形成され、当該電極基板(1)の他面(1B)には偏光手段(4)が形成され、前記電極基板(1)と対向配配取(6)が形成され、前記電極基板(5)の他面(5B)には偏光手段(7)が形成され、前記電極基板(1)とにより液晶層(8)が挟持され、前記電極(2)は、外部から印加される電圧により、電基板(1)の一面(1A)に対しほぼ平行な電界を発生するよう構成され、前記電極基板(1)の一面(1A)に形成された液晶配向膜(3)による液晶分子のプレチルト角が1。以下であることを特徴とする。(0008】本発明の液晶表示器子においては、電極基

(0008) 本発明の液晶表示素子においては、電極基板 (1) の一面 (1A) に形成された液晶配向膜 (3) が、 O 脂肪族および/または脂果式テトラカルポン酸ニ無水物 (以下「特定テトラカルポン酸ニ無水物」ともいう。) とジアミン化合物とを反応させて得られるポリアミック酸、 O 当該ポリアミック酸を脱水閉県して得

40

3

られるイミド化重合体、 ③ 特定テトラカルポン酸二無水物とジイソシアネート化合物とを反応させて得られるポリイミドから選ばれる少なくとも 1 種の重合体からなることが好ましい。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の液晶表示素子について詳細に説明する。図1は、本発明の液晶表示素子の主要部の構成を示し、(a)はセル側断面図、(b)はセル正面図である。同図において、1は電極基板、2は電極基板1の一面1A側に設けられて表示画素を形成する電極(共通電極21、画素電極22)、9は発験り上に形成された液晶配向膜、4は電極基板1の他面1B側に設けられた偏光板、5は電極基板1と対向配置された液晶配向膜、7は対向基板5の他面5B側に設けられた破晶配向膜、7は対向基板5の他面5B側により挟持されている液晶層である。

【0010】 ここに、電極基板 1 および対向基板 5 としては、例えばフロートガラス、ソーダガラスなどのガラス;ポリエチレンテレフタレート、ポリプチレンテレフタレート、ポリエーテルスルホン、ポリカーポネートなどのプラスチックからなる透明基板を用いることができる。

【0011】表示画素を形成する電極2は、外部から印加される電圧により、電極基板1の一面1Aに対しほぼ平行な電界Eを発生するように構成されている。なお、横電界制御方式における電極2は透明性を有する必要はなく、クロム電極などの金属電極を使用することもできる。

【0012】電極基板1における液晶配向膜3および対向基板5における液晶配向膜6は、液晶配8を構成する液晶配分子を配向させる機能を有する膜である。液晶配向膜3は、絶縁膜9上に液晶配向剤を塗布して樹脂膜を形成し、当該樹脂膜の表面にラピング、紫外線照射などによる配向処理を行うことにより形成することができる。また、液晶配向膜を形成し、当該樹脂膜の形成することができる。なお、液晶配向膜は、上配の方法以外に、一軸延伸法、ラングミュア・プロジェット法などで樹脂膜を得ることにより、形成することもできる。

【0013】 (位極基板1の他面1B側に設けられた偏光板4および対向基板5の他面5B側に設けられた偏光板7としては、例えば、ポリピニルアルコールを延伸配向させながらヨウ素を吸収させて形成される偏光板(以下「H 版」という)、酢酸セルロース保護膜によりH 版を挟んで形成される偏光板などを挙げることができる。偏光板4は、その偏光方向が電極基板1の一面1Aに形成された被品配向膜3の配向処理方向と一致または直交す

るように貼り合わせられ、個光板7は、その個光方向が 対向基板5の一面5Aに形成された液晶配向膜6の配向 処理方向と一致または直交するように貼り合わせられて いる。

【0014】この液晶表示素子においては、液晶配向膜3におけるラビング方向と液晶配向膜6における配向処理方向が直交または逆平行となるように、電極基板1と対向基板5とが対向配置され、電極基板1と対向基板5とにより液晶層8が挟持されている。

【0015】液晶層8を構成する液晶としては、ネマテ ィック型液晶およびスメクティック型液晶を挙げること ができ、その中でもネマティック型液晶が好ましく、例 えばシッフベース系液晶、アゾキシ系液晶、ピフェニル 系液晶、フェニルシクロヘキサン系液晶、エステル系液 晶、ターフェニル系液晶、ピフェニルシクロヘキサン系 液晶、ピリミジン系液晶、ジオキサン系液晶、ビシクロ オクタン系液晶、キュバン系液晶などを用いることがで きる。また、これらの液晶に、例えばコレスチルクロラ イド、コレステリルノナエート、コレステリルカーボネ 20 ートなどのコレステリック型液晶や商品名「C-15」 「СВ-15」 (メルク社製) として販売されているよ うなカイラル剤などを添加して使用することもできる。 さらに、p-デシロキシベンジリデン-p-アミノ-2 - メチルブチルシンナメートなどの強誘電性液晶も使用 することができる。

【 0 0 1 6 】 上記のような 構成の 液晶 表示素 子は、 例えば下記の方法によって 製造することができる。

【0017】(1)一定の間隔でパターニングされた駆動用の電極2が設けられた電極基板1の一面1Aに空化シリコンなどからなる絶縁膜9を形成する。次いで、形成された絶縁膜9上に、例えばロールコーター法、スピンナー法、印刷法などの方法によって液晶配向剤を塗布し、塗布面を加熱することにより樹脂膜を形成する。ここで、加熱温度は80~250℃とされ、好ましくは120~20~200℃とされる。形成される樹脂膜の膜厚は、通常0.001~1 μ mであり、好ましくは0.005~0.5 μ mである。

[0018] 絶縁膜9上に形成された樹脂膜面を、例えばナイロン、レーヨン、コットンなどの繊維からなる布を巻き付けたロールで一定方向に擦るラピング処理を行う。これにより、液晶分子の配向能が樹脂膜に付与されて液晶配向膜3となる。なお、ラピング処理時に発生する微粉体(異物)を除去して表面を荷浄な状態とするために、形成された液晶配向膜をイソプロピルアルコールなどによって洗浄することが好ましい。

【0019】(2)上配(1)と同様にして、対向基板5の一面5Aに液晶配向剤を塗布し、塗布面を加熱乾燥して樹脂膜を形成し、樹脂膜面のラピング処理を行うことにより、対向基板5の一面5Aに液晶配向膜6を形成50 する。

5

【0021】本発明の液晶表示素子は、横電界制御方式による液晶表示素子であって、電極基板の一面に形成された液晶配向膜(図1における液晶配向膜3)による液晶分子のプレチルト角が1。以下である点に特徴下るものである。液晶分子のプレチルト角が1。以下角が1。以野角依存性が小さくて広い視野角確開(例えば±65。以上)において良好な表示状態を確保することができる。また、かかる観点から、対向基での一面に形成された液晶配向膜(図1における液晶配向膜6)による液晶分子のプレチルト角も1。以下であることが好ましい。

【0022】被晶分子のプレチルト角を制御しやすい液品配向膜を構成する樹脂として、①特定テトラカルポン酸二無水物とジアミック酸 A」ともいう)、②特定では、一般などでは、一般などでは、一般などが、一般などができる。では、一般などでは、一般などができる。では、一般などで、一般などにより、、一般などにより、ないでは、一般などにより、、一般などにより、ないでは、一般などにより、、一般などにより、、一般などにより、、一般などにより、、一般などにより、、一般などにより、ないないできる。

【0023】 <ポリアミック酸 A>液晶配向膜を構成する樹脂として好適に使用することのできるポリアミック酸 Aは、特定テトラカルポン酸二無水物とジアミン化合物とを反応させることにより得られる。

【0024】ポリアミック酸Aの合成に用いられる特定テトラカルポン酸二無水物としては、例えばプタンテトラカルポン酸二無水物、1、2、3、4ーシクロプタンテトラカルポン酸二無水物、1、3ージクロプタンテトラカルポン酸二無水物、1、3ージクロロー1、2、3、4ーシクロプタンテトラカルポン酸二無水物、1、2、3、4ーシクロペンタ

ンテトラカルポン酸二無水物、1.2.4.5ーシクロ ヘキサンテトラカルポン酸二無水物、3,3',4, 4、-ジシクロヘキシルテトラカルポン酸二無水物、 2, 3, 5-トリカルポキシシクロペンチル酢酸二無水 物、3、5、6-トリカルポキシノルポルナン-2-酢 酸二無水物、 2 、 3 、 4 、 5 ーテトラヒドロフランテト ラカルボン酸二無水物、5-(2,5-ジオキソテトラ ヒドロフラル) -3-メチル-3-シクロヘキセン-1, 2-ジカルポン酸二無水物、ビシクロ[2, 2, 2] -オクト-7-エン-2, 3, 5, 6-テトラカル ポン酸二無水物などの脂肪族または脂環式テトラカルポ ン酸二無水物; 1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒ ドロー5ー(テトラヒドロー2、5ージオキソー3ーフ ラニル) - ナフト [1, 2-c] フラン-1, 3-ジオ ン、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒドロ-5-メチルー5- (テトラヒドロー2, 5-ジオキソー3-フラニル) -ナフト [1, 2-c] フラン-1, 3-ジ オン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 5 - エチルー5 - (テトラヒドロー2.5 - ジオキソー3 - フラニル) - ナフト [1, 2-c] フラン-1, 3-ジオン、1、3、3a、4、5、9b-ヘキサヒドロ-7-メチル-5-(テトラヒドロ-2, 5-ジオキソー 3-フラニル) -ナフト[1, 2-c] フラン-1, 3 - ジオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 7 - エチル - 5 - (テトラヒドロ - 2 、 5 - ジオキソ 3 - フラニル) - ナフト [1, 2 - c] フラン-1, 3-ジオン、1、3,3a,4,5,9b-ヘキサヒド ロー8-メチルー5-(テトラヒドロー2、5-ジオキ ソー3-フラニル) -ナフト [1, 2-c] フランー 1, 3-ジオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサ ヒドロー8-エチルー5-(テトラヒドロー2, 5-ジ オキソー3-フラニル) -ナフト [1, 2-c] フラン -1, 3-ジオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキ サヒドロー 5 、 8 ージメチルー 5 ー (テトラヒドロー 2, 5-ジオキソー3-フラニル) -ナフト[1, 2c] フラン-1, 3-ジオンなどのペンゼン環を有する 脂肪族テトラカルポン酸二無水物などを挙げることがで きる。これらの特定テトラカルポン酸二無水物は、単独 でまたは2種以上組み合わせて用いることができる。 【0025】これらのうち、ブタンテトラカルポン酸二

無水物、2、3、5ートリカルボキシシクロベンチル酢酸二無水物、1、3ージメチルー1、2、3、4ーシクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1、3、3 a、4、5、9 b ー ヘキサヒドロー5ー(テトラヒドロー2、5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト[1、2ーc]フランー1、3ージオン、1、3、3 a、4、5、9 b ー ヘキサヒドロー8ーメチルー5ー(テトラヒドロー2、5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト[1、2ーc]フランー1、3ージオンおよび1、3、3 a、50 4、5、9 b ー ヘキサヒドロー5、8ージメチルー5ー

(テトラヒドロー 2. 5-ジオキソー3-フラニル)ーナフト [1.2-c] フランー1.3-ジオンは、これらを含有してなる被晶配向剤が、保存安定性に優れたものとなることから特に好ましい。

【0026】ポリアミック酸Aの合成に用いられるジア ミン化合物としては、例えば1,2-フェニレンジアミ ン、3-メチル-1,2-フェニレンジアミン、4-メ チルー1, 2-フェニレンジアミン、4, 5-ジメチル -1、2-フェニレンジアミン、3-エチル-1、2-フェニレンジアミン、3-メチル-1,2-フェニレン ジアミン、4-エチル-1,2-フェニレンジアミン、 4, 5-ジエチル-1, 2-フェニレンジアミン、3-メトキシー1、2-フェニレンジアミン、4-メトキシ -1, 2-フェニレンジアミン、4, 5-ジメトキシー 1, 2-フェニレンジアミン、3-エトキシー1, 2-フェニレンジアミン、4-エトキシ-1,2-フェニレ ンジアミン、3-クロロ-1、2-フェニレンジアミ ン、4-クロロ-1,2-フェニレンジアミン、3-フ ルオロー1、2-フェニレンジアミン、4-フルオロー 1, 2-フェニレンジアミン、1, 3-フェニレンジア ミン、2-メチル-1,3-フェニレンジアミン、4-メチルー1、3-フェニレンジアミン、5-メチルー 1, 3-フェニレンジアミン、2-エチル-1, 3-フ ェニレンジアミン、4-エチル-1、3-フェニレンジ アミン、5-エチル-1,3-フェニレンジアミン、2 -メトキシ-1, 3-フェニレンジアミン、4-メトキ シー1, 3-フェニレンジアミン、5-メトキシー1, 3-フェニレンジアミン、4-エトキシ-1, 3-フェ ニレンジアミン、5-エトキシ-1,3-フェニレンジ アミン、4-クロロー1、3-フェニレンジアミン、5 -クロロ-1、3-フェニレンジアミン、4-フルオロ -1.3-フェニレンジアミン、5-フルオロ-1,3 -フェニレンジアミン、1,4-フェニレンジアミン、 2-メチル-1, 4-フェニレンジアミン、2, 3-ジ メチル-1, 4-フェニレンジアミン、2.5-ジメチ ルー1, 4-フェニレンジアミン、2, 6-ジメチルー 1, 4-フェニレンジアミン、2, 3-ジエチル-1, 4-フェニレンジアミン、2,5-ジエチル-1,4-フェニレンジアミン、2,6-エチル-1,4-フェニ ミン、2-エトキシ-1,4-フェニレンジアミン、2 - クロロー 1 、 4 - フェニレンジアミン、 2 、 3 - ジク ロロー1、4-フェニレンジアミン、2、5-ジクロロ -1,4-フェニレンジアミン、2,6-ジクロロー 1, 4-フェニレンジアミン、2-フルオロ-1, 4-フェニレンジアミン、2、3-ジフルオロ-1、4-フ ェニレンジアミン、2、5-ジフルオロ-1、4-フェ ニレンジアミン、2、6-ジフルオロ-1、4-フェニ レンジアミン、1、5-ジアミノナフタレン、3、3、 ージメチルー4、4′ージアミノピフェニル、2、

2', 5, 5'ーテトラクロロー4, 4'ージアミノビ フェニル、2、2'ージクロロー4、4'ージアミノー 5, 5'-ジメトキシピフェニル、3, 3'-ジメトキ シー4、4′ージアミノビフェニル、4、4′ージアミ ノー2、2'ーピス(トリフルオロメチル)ピフェニ ル、4、4′ージアミノジフェニルメタン、4、4′ー ジアミノジフェニルエーテル、9、9-ビス(4-アミ ノフェニル) フルオレン、4, 4'-(p-フェニレン イソプロピリデン) ビスアニリン、4, 4'-(m-フ 10 ェニレンイソプロピリデン) ビスアニリン、2, 2-ビ ス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] プロパ ン、4、4'-ジアミノジフェニルエタン、4、4'-ジアミノジフェニルスルホン、4、4′-ジアミノジフ - ェニルスルフィド、4、4'ージアミノベンズアニリ ド、3、4′ージアミノジフェニルエーテル、3、3′ - ジアミノベンゾフェノン、3,4'-ジアミノベンゾ フェノン、4、4'ージアミノペンゾフェノン、2、2 - ピス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ヘキ サフルオロプロパン、2,2-ビス(4-アミノフェニ 20 ル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス [4-(4 -アミノフェノキシ)フェニル]スルホン、1、4-ビ ス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、1, 3-ピス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、1, 3-ビス(3 ーアミノフェノキシ) ベンゼン、9、9ーピス (4ーア ミノフェニル) -10-ヒドロアントラセン、4,4' - メチレンーピス (2 - クロロアニリン)、2,2'-ピス [4-(4-アミノー2-トリフルオロメチルフェ ノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパン、4、4' - ピス [(4-アミノ-2-トリフルオロメチル) フェ 30 ノキシ] -オクタフルオロビフェニル、2, 7 - ジアミ ノフルオレン、5-アミノ-1-(4'-アミノフェニ ル) -1, 3, 3-トリメチルインダン、6-アミノー 1-(4'-アミノフェニル)-1,3,3-トリメチ ルインダンなどを挙げることができる。これらのジアミ ン化合物は、単独でまたは2種以上組み合わせて用いる

ことができる。

【0028】ポリアミック酸Aの合成反応に供される特定テトラカルポン酸二無水物とジアミン化合物の使用割合は、ジアミン化合物に含まれるアミノ基1当量に対して、特定テトラカルポン酸二無水物の酸無水物基が0.2~2当量となる割合が好ましく、さらに好ましくは0.3~1.2当量となる割合である。

50 【0029】ポリアミック酸Aの合成反応は、有機溶媒

9

中において、通常0~150℃、好ましくは0~100 ℃の温度条件下で1~48時間行われる。なお、反応条 件により、ポリアミック酸Aの一部がイミド化されたも のとなる場合があるが、本発明を構成する液晶配向膜を 形成する樹脂として使用することに何ら問題はない。こ の反応に用いられる有機溶媒としては、反応生成物であ るポリアミック酸Aを溶解し得るものであれば特に制限 はなく、例えばN-メチル-2-ピロリドン、N、N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミ ド、ジメチルスルホキシド、ァープチロラクトン、テト ラメチル尿素、ヘキサメチルホスホルトリアミドなどの 非プロトン系極性溶媒;m-クレゾール、キシレノー ル、フェノール、ハロゲン化フェノールなどのフェノー ル系溶媒を挙げることができる。また、有機溶媒の使用 侃は、通常、テトラカルポン酸二無水物およびジアミン 化合物の総量が、反応溶液の全量に対して0.1~30 重量%になるような量であることが好ましい。

【0030】なお、この有機溶媒には、ポリアミック酸 Aの貧溶媒であるアルコール類、ケトン類、エステル 類、エーテル類、ハロゲン化炭化水素類、炭化水素類 を、生成するポリアミック酸 A が析出しない程度の割合 で併用することができる。かかる貧溶媒としては、例え ばメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピル アルコール、シクロヘキサノール、エチレングリコー ル、プロピレングリコール、1,4-プタンジオール、 トリエチレングリコール、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイ ソプチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸 エチル、酢酸プチル、シュウ酸ジエチル、マロン酸ジエ チル、ジエチルエーテル、エチレングリコールメチルエ ーテル、エチレングリコールエチルエーテル、エチレン グリコール-n-プロピルエーテル、エチレングリコー ルーi-プロピルエーテル、エチレングリコールーn-ブチルエーテル、エチレングリコール-n-ヘキシルエ ーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレ ングリコールエチルエーテルアセテート、ジエチレング リコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエ チルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテ ル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチ レングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコ ールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコー ルメチルエーテルアセテート、エチレングリコールエチ ルエーテルアセテート、エチレングリコール - n - プロ ピルエーテルアセテート、エチレングリコールーiープ ロピルエーテルアセテート、エチレングリコール-n-ブチルエーテルアセテート、エチレングリコール - n -ヘキシルエーテルアセテート、4-ヒドロキシ-4-メ チルー2ーペンタノン、2ーヒドロキシプロピオン酸エ

チル、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチ

ル、2-ヒドロキシー2ーメチルプロピオン酸エチル、 エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2ーヒドロキシー3ーメチルプタン酸メチル、3ーメトキシプロピオン酸メチル、3ーエトキシプロピオン酸エチル、3ーエトキシプロピオン酸エチル、3ーエトキシプロピオン酸エチル、6ーエトキシプロロズタン、1、2ージクロロエタン、1、4ージクロロブタン、トリクロロエタン、クロルベンゼン、0ージクロルベンゼン、トリクロロエタン、オクタン、ベンゼン、トレンなどを挙げることができる。これらは単独でまたは2種以上組み合わせて用いることができる。

10

【0031】 <イミド化重合体 B>液晶配向膜を構成する樹脂として好適に使用することのできるイミド化重合体 Bは、下記方法(1)または方法(2)により調製することができる。このイミド化重合体 Bは、通常ポリイミドまたはポリイソイミドである。

【0032】方法(1):上記のポリアミック酸Aを加熱する。この方法における反応温度は、通常60~25 0℃とされ、好ましくは100~170℃とされる。反 20 応温度が60℃未満ではイミド化反応が十分に進行せず、反応温度が250℃を超えると得られるポリイミドの分子畳が低下することがある。

【0033】方法(2):ポリアミック酸 A を有機溶媒 に溶解し、この溶液中に脱水剤および脱水開環触媒を添 加し必要に応じて加熱することにより、脱水閉環(イミ ド化反応) させる。この方法において、脱水剤として は、例えば無水酢酸、無水プロピオン酸、無水トリフル オロ酢酸などの酸無水物を用いることができる。脱水剤 の使用量は、ポリアミック酸Aの繰り返し単位1モルに 対して1.5~20モルとするのが好ましい。また、脱 水開環触媒としては、例えばピリジン、コリジン、ルチ ジン、トリエチルアミンなどの第3級アミンを用いるこ とができるが、これらに限定されるものではない。脱水 開環触媒の使用量は、使用する脱水剤1モルに対して 0. 5~10モルとするのが好ましい。なお、脱水閉環 反応に用いられる有機溶媒としては、ポリアミック酸A の合成に用いられるものとして例示した有機溶媒を挙げ ることができる。脱水閉環反応の反応温度は、通常0~ 180℃、好ましくは60~150℃とされる。なお、 上記イミド化反応の反応条件をコントロールすることに よって、イミド化率を任意に調整することができる。

【0034】 <ポリイミドC>液晶配向談を構成する樹脂として好適に使用することのできるポリイミドCは、上記イミド化重合体Bのポリイミドと実質的に同一の化学構造を有するものであり、特定テトラカルポン酸二無水物とジイソシアネート化合物とを混合し、必要に応じて加熱して縮合させることにより調製することができる。

【0035】ポリイミドCの合成に用いられるジイソシ 50 アネート化合物としては、例えばヘキサメチレンジイソ

40

50

シアネートなどの脂肪族ジイソシアネート化合物:シク ロヘキサンジイソシアネートなどの脂類式ジイソシアネ ート化合物;ジフェニルメタンー4、4'ージイソシア ネート、ジフェニルエーテルー4、4′ージイソシアネ ート、ジフェニルスルホン-4,4'-ジイソシアネー ト、ジフェニルスルフィドー4、4′-ジイソシアネー ト、1, 2 - ジフェニルエタン-p, p' - ジイソシア ネート、2、2-ジフェニルプロパン-p, p' -ジイ ソシアネート、2、2-ジフェニル-1、1、1、3、 3, 3-ヘキサフルオロプロパン-p, p'-ジイソシ 10 アネート、2, 2-ジフェニルプタン-p, p'-ジイ ソシアネート、ジフェニルジクロロメタン-4,4'-ジイソシアネート、ジフェニルフルオロメタン-4, 4'-ジイソシアネート、ベンゾフェノン-4, 4'ジ イソシアネート、N-フェニル安息香酸アミドー4, 4' -ジイソシアネートなどの芳香族ジイソシアネート 化合物を挙げることができ、これらは、単独でまたは2 種以上組み合わせて用いることができる。なお、この反 応には特に触媒は必要とされず、反応温度は、通常50 ~200℃、好ましくは100~160℃である。

【0036】液晶配向膜を構成するポリアミック酸A、 イミド化重合体BおよびポリイミドCは、末端修飾型の ものであってもよい。この末端修飾型のポリアミック酸 およびポリイミドは、その分子型が好適な範囲に調節さ れ、末端修飾型の重合体を含有させることにより、本発 明の効果が損われることなく液晶配向剤の塗布特性など を改善することができる。このような末端修飾型の重合 体は、ポリアミック酸またはポリイミドを合成する際 に、酸一無水物、モノアミン化合物、モノイソシアネー ト化合物などを反応系に添加することにより合成するこ とができる。ここで、酸一無水物としては、例えば無水 マレイン酸、無水フタル酸、無水イタコン酸、n-デシ ルサクシニック酸無水物、n-ドデシルサクシニック酸 無水物、n-テトラデシルサクシニック酸無水物、n-ヘキサデシルサクシニック酸無水物、n-オクタデシル サクシニック酸無水物などを挙げることができ、モノア ミン化合物としては、例えばアニリン、シクロヘキシル アミン、n-プチルアミン、n-ペンチルアミン、n-ヘキシルアミン、n-ヘプチルアミン、n-オクチルア ミン、n-ノニルアミン、n-デシルアミン、n-ウン デシルアミン、 n - ドデシルアミン、 n - トリデシルア ミン、 n - テトラデシルアミン、 n - ペンタデシルアミ ン、n-ヘキサデシルアミン、n-ヘプタデシルアミ ン、n-オクタデシルアミン、n-エイコシルアミンな どを挙げることができ、モノイソシアネート化合物とし ては、フェニルイソシアネート、ナフチルイソシアネー トなどを挙げることができる。

【0037】液晶配向膜を構成するポリアミック酸A、イミド化重合体BおよびポリイミドCは、その対数粘度(nln)の値が通常0.05~10dl/gであるこ

[0038]

【数1】

n ℓ n (溶液流下時間/溶媒流下時間)

(ポリマーの重量機度)

【0039】 <液晶配向剤> 電極基板および対向基板における液晶配向膜は、それぞれの基板の一面に液晶配向剤を塗布し、塗布面を加熱乾燥して樹脂膜を形成し、樹脂膜表面のラピング処理を行うことにより形成することができる。かかる液晶配向剤は、以上詳述したポリアミック酸 A、イミド化重合体 B およびポリイミド C から選ばれる少なくとも 1 種の重合体を有機溶媒に溶解させることにより調製することができる。

20 【0040】上記重合体を溶解させる有機溶媒としては、これらを溶解できるものであれば特に制限されるものではなく、例えば、ポリアミック酸Aの合成反応に用いられるものとして例示した溶媒を挙げることができる。また、ポリアミック酸Aの合成反応の際に併用することができるものとして例示した貧溶媒も適宜選択して併用することができる。

【0041】被晶配向剤における重合体濃度は、通常 0.1~20重量%とされ、好ましくは0.5~10重 量%である。重合体濃度が0.1重量%未満である場合 には、塗膜(樹脂膜)の膜即が過小となって良好な液晶 配向膜を得ることができず、重合体濃度が20重量%を 超える場合には、塗膜の膜即が過大となって良好な液晶 配向膜を得ることができず、また、液晶配向剤の粘性が 増大して塗布特性が劣るものとなる。

【0042】また、液晶配向剤には、形成される液晶配 向膜の基板に対する密着性をさらに向上させることを目 的として官能性シラン含有化合物が含有されていてもよ い。かかる官能性シラン含有化合物としては、例えば3 - アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロ ピルトリエトキシシラン、2-アミノプロピルトリメト キシシラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラン、 トキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノ プロピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロピ ルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエト キシシラン、N-エトキシカルポニル-3-アミノプロ ピルトリメトキシシラン、N-エトキシカルポニル-3 - アミノプロピルトリエトキシシラン、N - トリエトキ シシリルプロピルトリエチレントリアミン、N-トリメ トキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、1013 "

トリメトキシイシリルー1、4、7-トリアザデカン、10-トリエトキシシリルー1、4、7-トリアザデカン、9-トリメトキシシリルー3、6-ジアザノニルアセテート、9-トリエトキシシリルー3,6-ジアザノニルアセテート、N-ベンジルー3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ベンジルー3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-フェニルー3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-ビスシランなどを挙げることができる。

[0043]

【実施例】以下、本発明を実施例により、さらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例に制限されるも のではない。なお、以下の実施例および比較例において 作製された液晶表示素子についての評価項目および評価 方法を以下に示す。

14

【0044】 〔液晶配向性〕液晶表示素子に低圧を印加・解除したときの液晶セル中における異常ドメインの有無を偏光顕微鏡で観察し、異常ドメインのない場合を「良好」と判定した。

【0045】 〔液晶分子のプレチルト角〕 「T. J. Schffer, et al., J. Appl. Phys., vol. 19, 2013 (1980)」に記載の10 方法に準拠して測定した。

【0046】〔視野角依存性〕表示画面において反転画像が生じず、下記数式によって求められるコントラストの値が10以上である視野角範囲を、上下方向および左右方向のそれぞれについて測定した。

[0047]

【数 2 】

電圧無印加時の液晶表示素子の透過率

40

【0048】〔残留電圧の測定〕液晶表示素子に10Vの直流電圧を1時間印加した後、電圧の印加を解除し、液晶セルに残留する電圧を測定した。この残留電圧が大きいほど表示画面に残像が生じやすい。

【0049】〔合成例1〕2、3、5ートリカルポキシシクロペンチル酢酸二無水物44、83g(0、20モル)と4、4、一ジアミノジフェニルメタン39、65g(0、20モル)とをNーメチルー2ーピロリドン565gに溶解させ、この溶液を60℃で6時間反応させた。次いで、得られた反応溶液を大過剰のメチルアルコールに注いで、反応生成物を沈澱させた。その後、沈殿物を分離してメチルアルコールで洗浄し、減圧下40℃で15時間乾燥させることにより、対数粘度(π1π)が1、47d1/gであるポリアミック酸〔これを「ポリアミック酸(A-1)」とする。〕79、2gを得た。

【0050】 [合成例2] 合成例1で得られたポリアミック酸(A-1)40.0gをN-メチル-2-ピロリドン800gに溶解させ、ピリジン35.2gと無水酢酸27.6gとを添加して110℃で4時間イミド化反応させた。次いで、合成例1と同様にして、反応生成物の沈殿・分離・洗浄・乾燥を行うことにより、対数粘度(η1n)が1.49d1/gであるイミド化重合体(これを「イミド化重合体(B-1)」とする。〕38.6gを得た。

【0051】 〔合成例3〕 4、4 ¹ ージアミノジフェニルメタンに代えて1、4ーフェニレンジアミン21、63g(0、20モル)を使用したこと以外は合成例1と同様にして対数粘度(η l n) が1、49d1/gであるポリアミック酸〔これを「ポリアミック酸(Aー2)」とする。〕62、4gを得た。次いで、ポリアミ

 り ック酸 (A-1) に代えてポリアミック酸 (A-2) 4
 0.0gを使用したこと以外は合成例 2 と同様にして、 対数粘度 (η l n) が 1.5 3 d l / g であるイミド化 重合体 [これを「イミド化重合体 (B-2)」とする。) 38.5gを得た。

【0052】 [合成例4] 4, 4' -ジアミノジフェニルメタンに代えて4, 4' - (p-フェニレンイソプロピリデン) ピスアニリン68.90g(0.20モル)を使用したこと以外は合成例1と同様にして対数粘度(n1n)が1.15d1/gであるポリアミック酸(A-3)」とする。】106.9gを得た。次いで、ポリアミック酸(A-1)に代えてポリアミック酸(A-3)40.0gを使用したこと以外は合成例2と同様にして、対数粘度(n1n)が1.23d1/gであるイミド化重合体(これを「イミド化重合体(B-3)」とする。】37.5gを得た、

【0053】 $\{6成例5\}$ 4 4 ' - % T \ge 1 % T \ge 1 % T \ge 1 % Y \ge 1 % Y \ge 1 % Y \ge 1 % \ge 1 \bigcirc 1

【0054】 [合成例6] 2, 3, 5 - トリカルポキシシクロペンチル酢酸二無水物に代えてブタンテトラカル50 ポン酸二無水物39,62g(0,20モル)を使用し

(B-5)」とする。〕36.6gを得た。

【0056】 (合成例8) 2, 3, 5-トリカルポキシシクロペンチル酢酸二無水物に代えて1, 3, 3 a,

4, 5, 9 b - ヘキサヒドロー5 - (テトラヒドロー2, 5 - ジオキソー3 - フラニル) - ナフト [1, 2 - c] フランー1, 3 - ジオン60.05g(0.20モ20ル) を使用したこと以外は合成例1と同様にして対数粘度(η1n)が0.96dl/gであるポリアミック酸[これを「ポリアミック酸(A-7)」とする。]90.7gを役た。次いで、ポリアミック酸(A-1)に代えてポリアミック酸(A-7)40.0gを使用したこと以外は合成例2と同様にして、対数粘度(η1n)が1.12dl/gであるイミド化重合体[これを「イミド化重合体(B-7)」とする。)36.1gを得た。

【0057】 〔合成例9〕 2、3、5ートリカルポキシシクロベンチル酢酸二無水物に代えて1、3、3 a、4、5、9 bーヘキサヒドロー8ーメチルー5ー(テトラヒドロー2、5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト [1、2-c] フランー1、3ージオン62、85g (0、20モル)を使用したこと以外は合成例1と同様にして対数粘度(η1n)が0、88d1/gであるポリアミック酸〔これを「ポリアミック酸(A-8)」とする。〕91、4gを得た。次いで、ポリアミック酸(A-1)に代えてポリアミック酸(A-8)40、0gを使用したこと以外は合成例2と同様にして、対数粘度(η1n)が1、02d1/gであるイミド化重合体〔これを「イミド化重合体(B-8)」とする。〕36、0gを得た。

【0058】 〔合成例10〕 2、3、5ートリカルポキシシクロペンチル酢酸二無水物に代えてペンゾフェノンテトラカルポン酸二無水物64、45g(0、20モル)を使用したこと以外は合成例1と同様にして対数粘度(η1n)が1、73d1/gであるポリアミック酸〔これを「ポリアミック酸(A-9)」とする。〕101、2gを得た。

【0059】 (合成例11) 2. 3. 5 ートリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物44. 83g (0. 20 モル)とジフェニルメタンー4. 4'ージイソシアネート50.05g (0. 20モル)とをNーメチルー2ーピロリドン565g に溶解させ、この溶液を170℃で3時間反応させた。次いで、合成例1と同様にして、反応生成物の沈殿・分離・洗浄・乾燥を行うことにより、対数粘度(η1n)が0.98dl/gであるボリイミド(これを「ポリイミド(C-1)」とする。)70.6gを得た。

16

【0060】 〔比較合成例1〕 2、3、5 - トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物に代えてピロメリット酸二無水物43.62g(0.20モル)を使用したこと以外は合成例1と同様にして対数粘度(nln)が1.75dl/gであるポリアミック酸〔これを「ポリアミック酸(a-1)」とする。〕81.2gを得た。【0061】 < 実施例1>

(1) 液晶配向剤の調製:合成例1で得られたポリアミック酸(A-1)5.0gを、N-メチル-2-ピロリドン90重量%と3-エトキシプロピオン酸エチル10重量%とからなる混合溶媒に溶解させて、固形分濃度4重量%の溶液を得、この溶液を孔径1μmのフィルターで滤過することにより液晶配向剤を調製した。

【0062】(2)液晶表示素子の作製:

① 40μmの間隔でパターニングされたクロム電極が 設けられているホウケイ酸ガラスよりなる基板(電極基 板)の一面に、スパッタリングによって空化シリコンか らなる厚さ1500Åの絶縁膜を積層形成した。

【0063】② 絶縁膜が積層形成された前記電極基板の一面に、上記のようにして調製された液晶配向剤を塗布用印刷機を用いて塗布し、180℃で1時間乾燥することにより乾燥膜厚0.05μmの樹脂膜を形成した。次いで、形成された樹脂膜の表面を、レーヨン製の布を巻き付けたロールを備えたラピングマシーンを用いてラピング処理を施すことにより液晶配向膜を形成した。ここに、ラピング処理は、ロールの回転数500rpm、ステージの移動速度1cm/秒とした。なお、ラピング処理を施した後、形成された液晶配向膜をイソプロピルアルコールにより洗浄した。

0 【0064】 ② ホウケイ酸ガラスよりなる基板(対向 基板)の一面に、上配②と同様にして、液晶配向剤の塗 布および塗膜の乾燥を行って樹脂膜を得、当該樹脂膜の 表面にラピング処理を施すことにより液晶配向膜を形成 した。

【0065】 ② 上配のようにして液晶配向膜が形成された電極基板および対向基板のそれぞれの外縁部に、直径2μmの酸化アルミニウム球を含有するエポキシ樹脂系接着剤をスクリーン印刷法により釜布した後、それぞれの基板の液晶配向膜が相対し、しかも、それぞれの基50 板の液晶配向膜のラピング方向が直交するように、電極

基板と対向基板とを間隙を介して対向配置し、外縁部同 士を当接させて圧着して接着剤を硬化させた。

【0067】本実施例により作製された液晶表示素子は、電圧を印加・解除したときに液晶セル中に異常ドメインが認められず、良好な液晶配向性を有するものであった。また、良好な表示を維持できる視野角範囲は、左右方向で±70°、上下方向で±70°であり、この液晶表示素子は、視野角依存性が小さくて広い範囲にわたり良好な表示状態を確保することのできるものであった。さらに、残留電圧が0.12Vと小さく、表示画面に残像が生じにくいものであった。評価結果を下記表1に示す。

【0068】 (実施例2~11) 下記表1に示す処方に 従って、ポリアミック酸 (A-1) に代えて合成例2~ 11で得られたポリアミック酸A、イミド化重合体BまたはポリイミドCを使用したこと以外は実施例1と同様にして液晶配向剤を調製し、調製された液晶配向剤を調製し、調製された液晶配向原各を用いて電極基板および対向基板上に液晶配向膜を形成したこと以外は実施例1と同様にして本発明の液晶表示素子について、液晶分子のプレチルト角の測定、液晶配向性の評価、視野角範囲の測定(視野角な存性の評価)および残留電圧の測定(残像の生じやすの評価)を行った。評価結果を下記表1に併せて示す。

【0069】【比較例1】ポリアミック酸(A-1)に代えて比較合成例1で得られたポリアミック酸(a-1)を使用したこと以外は実施例1と同様にして液晶配向剤を調製し、当該液晶配向剤を用いて電極基板および対向基板上に液晶配向膜を形成したこと以外は実施例1と同様にして液晶表示素子を作製した。このようにして作製された液晶表示素子について、液晶分子のプレチルト角の測定、液晶配向性の評価、視野角範囲の測定(視野角依存性の評価)および残留電圧の測定(残像の生じ20 やすさの評価)を行った。評価結果を下記表1に併せて示す。

[0070]

【表 1 】

Г		液晶配向剤の調製に使用	被品分子	液晶	祖野角範囲(°)		残留電圧
		したポリアミック酸または ポリイミド	のプレチ ルト角	配向性	左右	上下	(V)
	1	ポリアミック酸(A – 1)	0.8°	良好	±70	±70	0.12
実	2	イミド化重合体(B-1)	0. 9°	良好	± 6 8	± 6 8	0.13
_	3	イミド化重合体(B-2)	0.9°	良好	±88	± 6 7	0. 1 I
膇	4	イミド化重合体(B – 3)	0.4°	良好	±73	±72	0.19
例	5	イミド化賞合体(B-4)	0.2	良舒	±73	±73	0.18
	6	イミド化賞合体(B – 5)	0.7*	良釪	± 7 0	± 7 0	0.18
	7	ポリアミック酸(A - 6)	0.8°	良好	±70	± 7 0	0.14
	В	イミド化重合体(B-7)	0. 9*	良好	±69	±70	0.19
	θ	イミド化重合体(B - 8)	0. 7°	良好	±71	±71	0.13
	10	ポリアミック酸(A-9)	0.9°	良好	± 6 8	±68	1. 05
	11	ポリイミド (C-1)	0.9*	良好	±67	±67	0. 25
比	文例	ポリアミック酸 (a-1)	1. 5	良好	± 6 5	± 5 3	1.12

[0071]

【発明の効果】本発明の液晶表示素子は、横電界制御方式でありながら、視野角依存性が小さく、広い視野角範囲にわたって良好な表示状態を確保することができ、しかも、電圧の印加を解除した後における残留電圧が小さいために表示画面に残像が生じにくく、コントラストの高い優れた表示性能を有するものである。

【0072】なお、本発明の液晶表示案子を構成する液晶配向膜に対して、例えば特開平6-22366号公報や特開平6-281937号公報に示されているよう

な紫外線を照射することによってプレチルト角を変化させるような処理、特関平5-107544号公報に示されているようなラピング処理を施した被品配向版の表面にレジスト版を部分的に形成し、先のラピング処理と異なる方向にラピング処理を行った後にレジスト版を除去して、液晶配向版の配向能を変化させるような処理を行うことによって、液晶表示素子の視野角依存性をさらに小さくすることが可能である。

【0073】本発明の液晶表示素子は、種々の装置に有 効に使用することができ、例えば卓上計算機、腕時計、 19 1 9.

図時計、計数表示板、ワードプロセッサ、パーソナルコンピュータ、液晶テレビなどの液晶表示装置として好適 に用いることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶表示素子の主要部の構成を示すセル側断面図およびセル正面図である。

【符号の説明】

- 1 電極基板
- 2 電極

21 共通電極

22 画素電極

3 液晶配向膜

4 偏光板

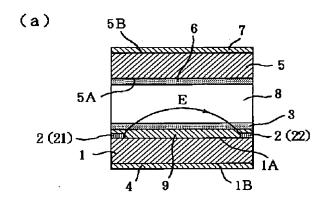
5 対向基板

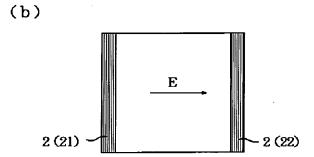
6 液晶配向膜

8 液晶層

9 絶縁膜

[図1]





フロントページの続き

(72)発明者 六鹿 秦顕

東京都中央区築地2丁目11番24号 日

本合成ゴム株式会社内

(72)発明者 松木 安生

東京都中央区築地2丁目11番24号 日

本合成ゴム株式会社内